



PR N° C3124C

## STMicroelectronics annonce la construction d'une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium en Italie

- *Première usine du genre pour la fabrication de substrats épitaxiés\* en carbure de silicium (SiC) en Europe.*
- *Une intégration verticale complète pour renforcer l'approvisionnement en substrats pour les solutions et composants en SiC permettant aux clients de l'automobile et de l'industriel d'évoluer vers l'électrification et une efficacité énergétique accrue.*

**Genève (Suisse), le 5 octobre 2022 — STMicroelectronics (NYSE : STM)**, un leader mondial des semi-conducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les applications des secteurs de l'automobile et de l'industriel dans le cadre de la transition vers l'électrification et de la poursuite d'un rendement énergétique accru. La production devrait démarrer en 2023, permettant d'équilibrer l'approvisionnement en substrats SiC entre la fabrication interne et l'achat à des fournisseurs.

Construite sur le site ST de Catane (Sicile-Italie) à côté de l'actuelle unité de fabrication de composants SiC, cette usine de production de substrats en SiC sera la première du genre en Europe pour la production en volumes de substrats épitaxiés en 150 mm en carbure de silicium, intégrant toutes les étapes du flux de production. ST s'est engagé à développer des plaquettes en 200 mm dans un futur proche.

Ce projet représente une étape clé dans l'évolution de la stratégie d'intégration verticale de ST pour ses activités SiC. L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience (*National Recovery and Resilience Plan*) et environ 700 emplois directs supplémentaires seront créés lorsque l'unité sera à pleine capacité.

« *ST transforme ses activités de fabrication à l'échelle mondiale, avec des capacités supplémentaires en production de plaquettes de 300 mm et en mettant tout particulièrement l'accent sur les semi-conducteurs à grand gap, pour réaliser son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et au-delà. Nous étendons nos activités à Catane, le centre de notre expertise dans le domaine des semi-conducteurs de puissance où nous avons d'ores et déjà intégré les activités de recherche, de développement et de fabrication de composants en SiC avec une solide collaboration avec des entités de recherche, des universités et des fournisseurs italiens* », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « *Cette nouvelle unité jouera un rôle clé vers l'intégration verticale de nos activités dans le domaine du carbure de silicium, renforçant notre capacité d'approvisionnement en substrats SiC à mesure que nous continuons d'augmenter les volumes au bénéfice de nos clients des secteurs de l'automobile et de l'industriel et de leur transition vers l'électrification et la poursuite d'une efficacité énergétique accrue.* »

\*La croissance par épitaxie (ou simplement épitaxie) est la première étape du processus qui a lieu sur le substrat pour fabriquer des dispositifs de puissance et qui détermine les caractéristiques finales du dispositif à fabriquer.

Le leadership de ST dans le domaine du carbure de silicium est le fruit de 25 années d'efforts et d'engagements en faveur de la R&D avec un large portefeuille de brevets clés. Depuis longtemps, Catane joue un rôle important dans la capacité d'innovation de ST en tant que lieu des principales activités de R&D et de fabrication en SiC du Groupe, contribuant avec succès au développement de nouvelles solutions permettant de produire des composants SiC avec une qualité et des volumes croissants. S'appuyant sur un écosystème solidement établi dans le domaine de l'électronique de puissance, avec notamment une collaboration fructueuse à long terme entre ST et différentes parties prenantes (l'Université, le Conseil national italien de la recherche (CNR) et plusieurs entreprises participant à la fabrication d'équipements et de produits), ainsi que sur un vaste réseau de fournisseurs, cet investissement renforcera le rôle de Catane en tant que centre de compétences mondial pour la technologie en carbure de silicium et pour de nouvelles opportunités de croissance.

Les produits STPOWER en carbure de silicium haute performance de ST sont actuellement fabriqués dans les usines ST de Catane (Italie) et d'Ang Mo Kio (Singapour), tandis que les activités d'assemblage et de test sont assurées par les sites Back-End de Shenzhen (Chine) et de Bouskoura (Maroc). L'investissement dans cette unité de fabrication de substrats en SiC capitalise sur cette expertise et marque une étape majeure pour ST qui ambitionne de disposer en interne d'une capacité de fabrication permettant d'atteindre 40 % de ses besoins en substrats d'ici 2024.

### **À propos de STMicroelectronics**

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site [www.st.com](http://www.st.com).

### **Pour plus d'informations, contacter :**

#### **Contact presse**

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

[nelly.dimey@st.com](mailto:nelly.dimey@st.com)

#### **Relations avec les Investisseurs**

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

[celine.berthier@st.com](mailto:celine.berthier@st.com)